

Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, **не позднее 6 августа 2025 г.**

Учет индивидуальных достижений, поступающих осуществляется следующими способами:

1) приемная комиссия начисляет поступающему баллы, которые включаются в сумму конкурсных баллов:

за общие индивидуальные достижения;

за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются в соответствии с пунктом 9.9. Правил при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения.

2) приемная комиссия учитывает индивидуальные достижения при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования в конкурсных списках.

Самарский университет устанавливает перечень индивидуальных достижений и порядок их учета:

Вид индивидуального достижения	Подтверждающие документы	Начисляемый балл	Максимальная сумма баллов
Общие индивидуальные достижения и порядок их учета			
Публикация, - опубликованная в изданиях, включенных в перечень ВАК; - опубликованная в изданиях, индексируемая в международных базах данных Scopus или Web of Science	Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью (Scopus, Web of Science, РИНЦ, ВАК), должны быть предоставлены: • титульный лист журнала, где была опубликована статья, • первый лист статьи (где указан(ы) автор(ы), название статьи),	1	6
Публикация, опубликованная в изданиях, включенных в РИНЦ	• подтверждение индексируемости статьи 	0,2	1
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец/свидетельство	Копия соответствующих документов, удостоверяющих авторство полученных охранных документов на результат интеллектуальной деятельности	1	2
Диплом о высшем образовании и о квалификации с отличием	Копия диплома	1	1
Согласие от предполагаемого научного руководителя о научном руководстве	Согласие (Приложение 6 Правил)	0,5	0,5

Вид индивидуального достижения	Подтверждающие документы	Начисляемый балл	Максимальная сумма баллов
Наличие рекомендации государственной экзаменационной комиссии к поступлению в аспирантуру	Копия протокола государственной экзаменационной комиссии	0,5	0,5
Победитель или призер всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО) в соответствии с направлением подготовки аспирантуры	Копия диплома или сертификата победителя, или призера ВСО	1	2
Медалист, победитель, призер Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»	Копия утвержденных списков победителей и призеров	2	2
Победитель или призер Всероссийского инженерного конкурса (ВИК)	Копия диплома победителя или призера ВИК	2	2
Только для поступающих на места в пределах целевой квоты на основании заявок на заключение договора о целевом обучении			
Участие в профориентационных мероприятиях	Список участников профориентационных мероприятий, представленном заказчиком в Самарский университет	1	1

Примечания:

1 Добавление баллов за каждое индивидуальное достижение проводится только при представлении подтверждающих документов.

2 Баллы за индивидуальные достижения засчитываются при условии соответствия наименованию группы научных специальностей, на которую подаются документы, конкурсной группе (за исключением баллов, полученных за диплом о высшем образовании и о наличии рекомендации государственной экзаменационной комиссии).

3 Статьи, опубликованные в издании, индексируемом в международных базах данных Scopus и Web of Science, а также включенном в перечень ВАК и/или РИНЦ, учитываются не более одного раза, причем выбор предпочтительного вида индивидуального достижения остается на усмотрение поступающего.

➡ Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью (Scopus, Web of Science, РИНЦ, ВАК), нужно предоставить распечатку скрина с сайта scopus.com, elibrary.ru, webofscience.com, для каждой учитываемой статьи

1) В распечатке должна быть следующая информация (Приложение 1):

- ФИО автора,
- название статьи,
- название журнала,
- подтверждение включения статьи/журнала в РИНЦ/ВАК/Scopus/Web of Science

2) Если сама статья не индексируется, но журнал, в котором опубликована статья, включен в базу РИНЦ/ВАК/Scopus/Web of Science, то помимо скрина статьи нужно приложить скрин журнала с соответствующего сайта (scopus.com, elibrary.ru, webofscience.com), с подтверждением включения журнала в соответствующую базу (Приложение 2).

3) Для статей, индексируемых в базе Scopus, необходимо

- приложить распечатку из личного кабинета сайта scopus.com, где будет видно ФИО автора и список статей (Приложение 3)
- приложить распечатку из вкладки Сведения об источнике, с информацией «Годы охвата Scopus» для каждого журнала, где опубликованы статьи (Приложение 4)



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU



ВХОД

IP-адрес компьютера:
91.222.128.24

Название организации:
Самарский национальный
исследовательский
университет им. акад. С.П.
Королева

Имя пользователя:

Пароль:

Вход

☐ Запомнить меня

☒ Правила доступа

☒ Регистрация

☒ Забыли пароль?

☒ Вход через Вашу
организацию

КОРЗИНА

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 46500007 EDN: YKWMW DOI: 10.18469/1810-3189.2021.24.2.68-72

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕРМАНИЕВЫХ МДП-СТРУКТУР С
ФТОРИДАМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

САЧУК Н.В.¹, ШАЛИМОВА Н.Б.¹

¹ Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086,
Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 24 Номер: 2 Год: 2021 Страницы: 68-72

УДК: 53.097

ЖУРНАЛ:

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Учредители: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева
ISSN: 1810-3189

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

МДП-СТРУКТУРА, ФТОРИДЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАТВОРНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК,
ДЕГРАДАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКА

АННОТАЦИЯ:

Исследовались электрические свойства МДП-структур с фторидами редкоземельных элементов на подложках германия для анализа возможности использования данных материалов в качестве затворных диэлектриков устройств. Структуры изучаются также с точки зрения оценки деградации их электрофизических свойств под действием электрических полей ~108 В/м, которые действуют на диэлектрик в процессе электроформовки, поскольку МДП-структуры с фторидами редкоземельных элементов обладают свойством бистабильного переключения. Исследования вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик показывают, что все структуры имеют примерно одинаковое значение плотности поверхностных состояний на границе раздела фторид редкоземельного элемента / Ge. Токи утечки в МДП-структурах с пленкой TmF3 и SmF3 меньше, чем в МДП-структурах с пленкой NdF3 большей толщины. Также не наблюдается эффекта уменьшения плотности тока при использовании двойной пленочной структуры CeF3/DyF3. Наиболее перспективным материалом с малым током утечки при довольно высоком значении диэлектрической проницаемости в германиевых МДП-структурах является тонкопленочный фторид самария.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1 Входит в РИНЦ®: да	2 Цитирований в РИНЦ®: 0
2 Входит в ядро РИНЦ®: нет	2 Цитирований из ядра РИНЦ®: 0
2 Норм. цитируемость по журналу:	2 Импорт-фактор журнала в РИНЦ: 0,223
2 Норм. цитируемость по направлению:	2 Дециль в рейтинге по направлению:
2 Тематическое направление: Physical sciences and astronomy	
2 Рубрика ГРНТИ: Физика	

АЛТМЕТРИКИ:

2 Просмотров: 9 (4)	2 Загрузок: 2 (1)	2 Включено в подборки: 2
2 Всего оценок: 0	2 Средняя оценка:	2 Всего отзывов: 0

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF GERMANIUM MIS STRUCTURES WITH RARE-EARTH ELEMENT
FLUORIDES

SACHUK NATALIA V.¹, SHALIMOVA MARGARITA B.¹

¹ Samara National Research University, 34, Moskovskoe shosse, Samara, 443086, Russia



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА

eLIBRARY ID: 9210

Язык описания: русский

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ? Тип серийного издания: периодическое издание
- ? Элементы серийного издания: выпуск журнала
- ? Назначение издания: научное
- ? Способ распространения: в печатном и электронном виде
- ? Доступ к полным текстам: все выпуски в открытом доступе
- ? Основной источник финансирования: учредитель
- ? Мультидисциплинарность: не является мультидисциплинарным
- ? Язык публикаций: русский, английский

УЧРЕДИТЕЛИ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара)

РЕДАКЦИЯ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара)

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕДАКЦИИ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ:

? ISSN печатной версии: 1810-3189	? ISSN электронной версии:
? Число выпусков в год: 4	? Год основания: 1998
? Число статей в выпуске: 12	? Период выпуска: 1998-...
? Число страниц в выпуске: 90	? Архив на eLIBRARY.RU: 2007-2022
? Всего статей на eLIBRARY.RU: 1019	? Всего выпусков на eLIBRARY.RU: 94
? Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-68199 от 27.12.2016	

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:

Журнал «Физика волновых процессов и радиотехнические системы» – периодический теоретический и научно-практический журнал, в котором публикуются результаты оригинальных научных исследований по разделам: Радиоп физика, Оптика, Радиотехника, Антенны, СВЧ устройства

ПОИСК

ВХОД

IP-адрес компьютера:
91.222.128.24

Название организации:
Самарский национальный
исследовательский
университет им. акад. С.П.
Королева

Имя пользователя:

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва)
Яцышен Валерий Васильевич ☒
Волгоградский государственный университет (Волгоград)
Яшин Алексей Афанасьевич ☒
Тульский государственный университет (Тула)

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ:

? Вид: одностороннее слепое рецензирование	? Число рецензентов: 1
? Доля отклоненных рукописей: 4	? Срок публикации: 30 дней
? Рецензирование осуществляется: членами редакционной коллегии	

РУБРИКИ ГРНТИ:

290000. Физика
470000. Электроника. Радиотехника

РУБРИКИ OECD:

103. Physical sciences and astronomy
202. Electrical engineering, electronic engineering

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВАК:

010304. Радиофизика
010306. Оптика
020213. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
020214. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии
020202. Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств

ИНДЕКСАЦИЯ:

? eLIBRARY.RU: да (договор 356-09/2019)	? RSCI: нет
? РИНЦ: да	? ESCI: нет
? Ядро РИНЦ: нет	? Web of Science: нет
? Перечень ВАК РФ: да	? Scopus: нет
? CrossRef: да	? Префикс DOI: 10.18469/1810-3189
? DOAJ: нет	
? Базы данных:	

* © 2000-2022 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены *



[Поиск](#) [Списки](#) [Источник](#)

2 публикации об авторе зарегистрированы Scopus Подробнее

Sachuk, N. V.

[Samaran National Research University, Samara, Russian Federation](#) Показать всю информацию об авторе

[56747828200](#) [ORCID](#) [Связать с ORCID](#)

[Редактировать профиль](#) [Настроить оповещение](#) [Потенциальные соответствия авторов](#)

[Экспортировать в SciVal](#)

Обзор показателей

2
Документы по автору

3
Цитирования в 3 документах

1
h-index: [View h-graph](#)

Документ и тенденции цитирования



[Анализировать результаты по автору](#) [Обзор цитирования](#)

Темы с наибольшим вкладом 2017–2021

Germanium Oxides; Gate Dielectrics; MOSFET

[1 документ](#)

[Просмотреть все темы](#)

[2 документа](#) [Цитирования в 3 документах](#) [0 препринтов](#) [1 соавтор](#) [1 тема](#) [0 выданных грантов](#)

[Экспортировать все](#) [Добавить все в список](#)

Сортировать по [Дата \(самые новые\)](#)

> [Просмотреть список в формате результатов поиска](#)

> [Просмотр приставочных ссылок](#)

[Настроить оповещение о документах](#)

Features of MIS Structures with Samarium Fluoride on Silicon and Germanium Substrates

Shalimova, M.B.; Sachuk, N.V.

[Semiconductors](#), 2019, 53(2), pp. 229–233

[Просмотреть реферат](#) [View at Publisher](#) [Связанные документы](#)

1
Цитирования

Degradation of the electrical characteristics of MOS structures with erbium, gadolinium, and dysprosium oxides under the effect of an electric field

Shalimova, M.B.; Sachuk, N.V.

[Semiconductors](#), 2015, 49(8), pp. 1045–1051

[Просмотреть реферат](#) [View at Publisher](#) [Связанные документы](#)

2
Цитирования

Отобразить [10 результаты](#)

[1 страница](#)



Поиск Списки Источники SciVal ? Войти

Создать учетную запись

Сведения об источнике

Отзыв > Сравнить источники >

Semiconductors

Предыдущее наименование: Soviet physics Semiconductors

Годы охвата Scopus: с 1996 по настоящий момент

Издатель: Pleiades Publishing

ISSN: 1063-7826 E-ISSN: 1090-6479

Отрасль знаний: Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics

Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics

Тип источника: Журнал

Просмотреть все документы >

Настроить уведомление о документах

Сохранить в список источников Source Homepage

CiteScore 2021
1.4

SJR 2021
0.263

SNIP 2021
0.447

CiteScore CiteScore рейтинг и тренды Содержание Scopus



Улучшенная методика расчета CiteScore

Рейтинг CiteScore 2021 отражает количество цитирований в 2018-2021 гг. статей, обзоров, материалов конференций, глав книг и информационных документов, опубликованных в 2018-2021 гг., деленное на количество публикаций за 2018-2021 гг. Подробнее >

CiteScore 2021

$$1.4 = \frac{1\,890 \text{ цитирований за 2018 - 2021 гг.}}{1\,305 \text{ документов за 2018 - 2021 гг.}}$$

CiteScoreTracker 2022

$$1.4 = \frac{1\,379 \text{ цитирований на текущую дату}}{954 \text{ документов на текущую дату}}$$